Super Fast Recovery Diode

D1FL20U

200V 1.1A

特 長

- 小型SMD
- 低ノイズ
- trr−35ns

Feature

- Small SMD
- Low Noise
- trr−35ns

用 途

- スイッチング電源
- DC/DCコンバータ
- フライホール
- 家電、OA、照明
- 通信、FA

Main Use

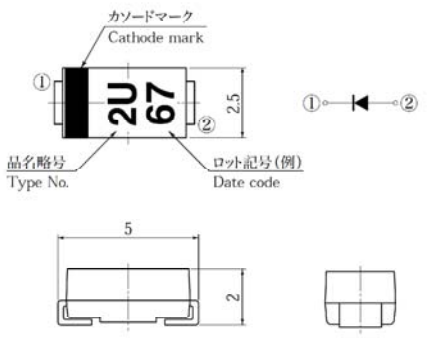
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Fly Wheel
- Home Appliance, Office Automation, Lighting
- Communication, Factory Automation

■外観図 OUTLINE

Package：1F

Unit:mm

Weight 0.058g(Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings（指定のない場合 Tl＝25℃）

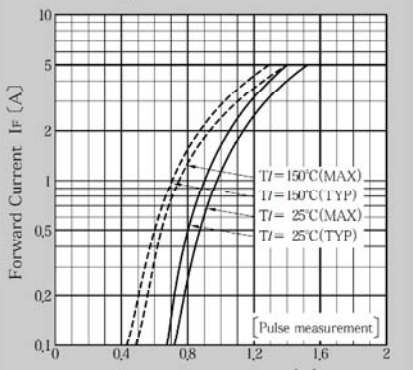
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D1FL20U	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			−55〜150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			200	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz正弦波，抵抗負荷，Ta＝25℃ 50Hz sine wave, Resistance load, Ta=25℃	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1.1	A
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	0.84	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦波，非繰り返し1サイクルせん頭値，Tj＝25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃		20	A

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics（指定のない場合 Tl＝25℃）

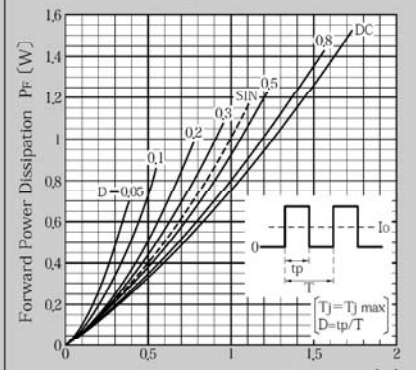
順電圧 Forward Voltage	V_F	I_F＝1.1A, パルス測定 Pulse measurement		MAX 0.98	V
逆電流 Reverse Current	I_R	V_R＝V_{RM}, パルス測定 Pulse measurement		MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I_F＝0.5A, I_R＝1A		MAX 35	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	θjl	接合部・リード間 Junction to lead		MAX 23	℃/W
	θja	接合部・周囲間 Junction to ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	MAX 108	
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	MAX 157	

■特性図　CHARACTERISTIC DIAGRAMS

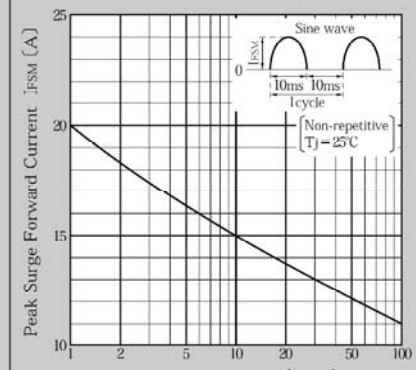
順方向特性
Forward Voltage



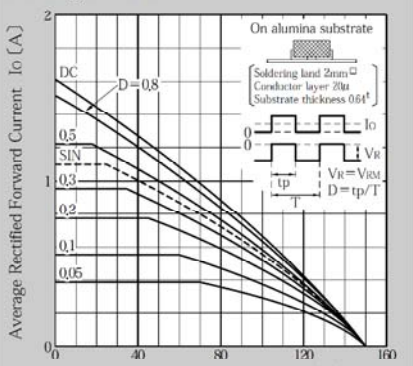
順電力損失曲線
Forward Power Dissipation



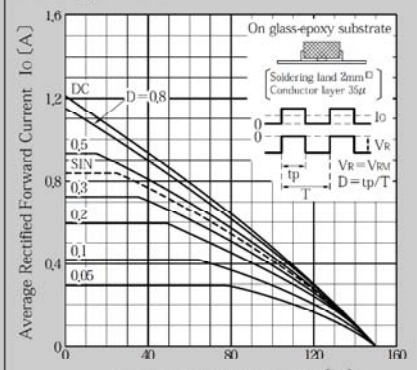
せん頭サージ順電流耐量
Peak Surge Forward Current Capability



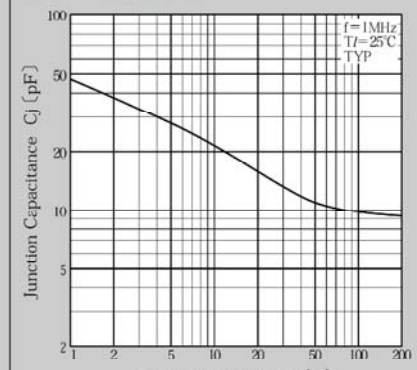
ディレーティングカーブ Ta-Io
Derating Curve Ta-Io



ディレーティングカーブ Ta-Io
Derating Curve Ta-Io



接合容量
Junction Capacitance



＊Sine waveは50Hzで測定しています。
＊50Hz sine wave is used for measurements.
＊半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typicalは統計的な実力を表しています。
＊Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9